

关键指标

- RF/LO 频段：8~12GHz
- IF 频段：DC~3GHz
- 变频增益：15dB
- 本振功率：0dBm
- 芯片尺寸：3.34mmX1.22mmX0.1mm

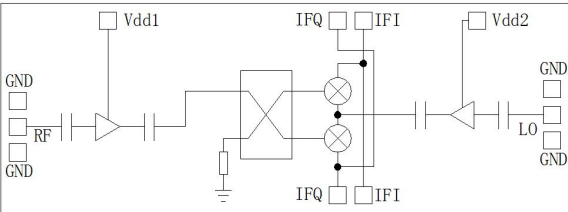
典型应用

- 电子对抗
- 雷达
- 卫星通讯
- 测试测量

产品简介

XT3511 是一种 IQ 混频器。该芯片采用 GaAs 工艺中制造，无须外部元件或匹配电路。该芯片有全表面钝化保护提高可靠性。

功能框图



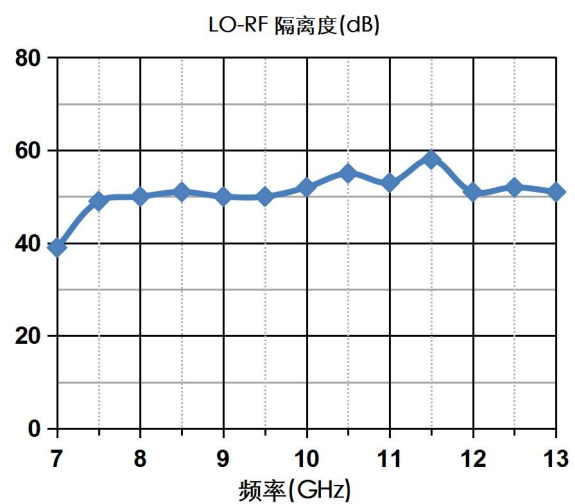
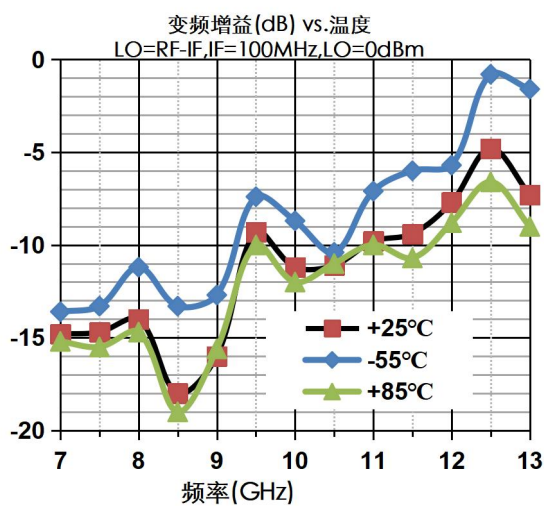
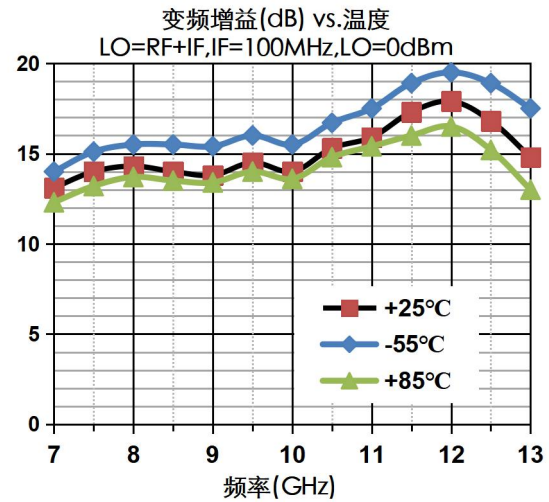
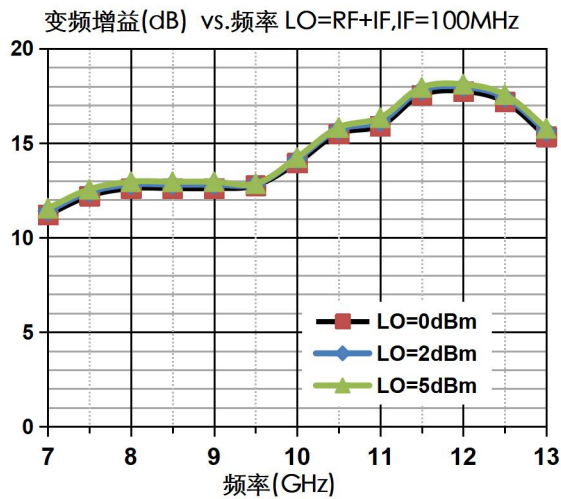
电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, LO=0dBm, IF=100MHz)

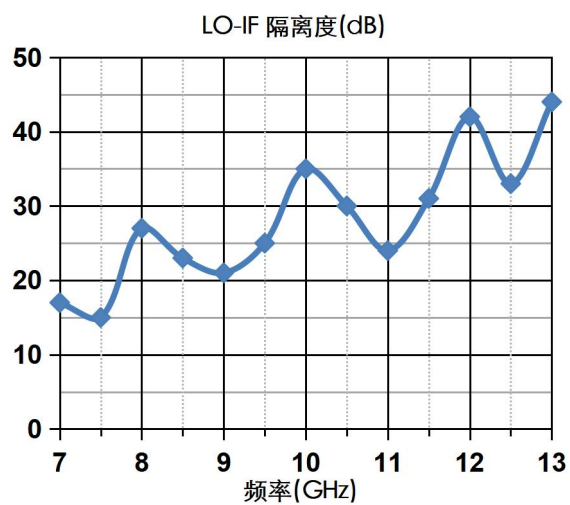
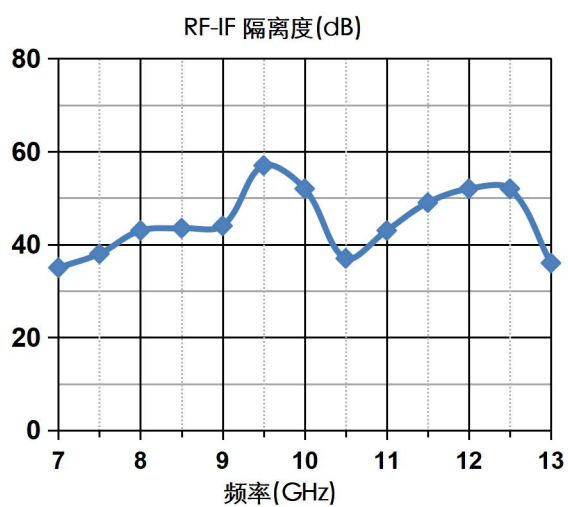
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率/本振频率	8~12			GHz
中频频率	DC~3			GHz
变频增益	—	15	—	dB
本振-射频隔离度	—	-50	—	dB
本振-中频隔离度	—	-30	—	dB
射频-中频隔离度	—	-40	—	dB
LO 驻波比	—	1.4	—	: 1
RF 驻波比	—	1.4	—	: 1

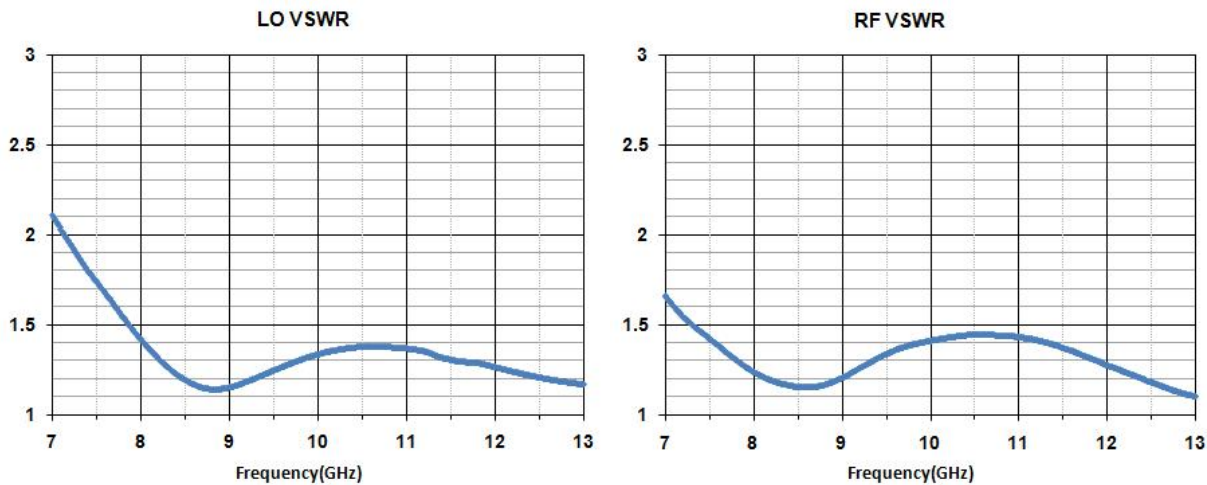
绝对最大额定值

射频/中频最大输入功率	20dBm	工作温度	-55℃~+85℃
本振最大输入功率	20dBm	存储温度	-65℃~+150℃

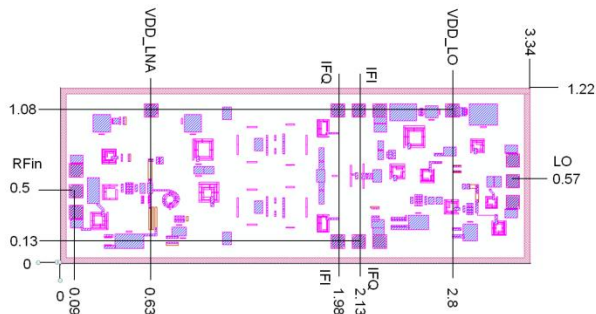
典型测试曲线



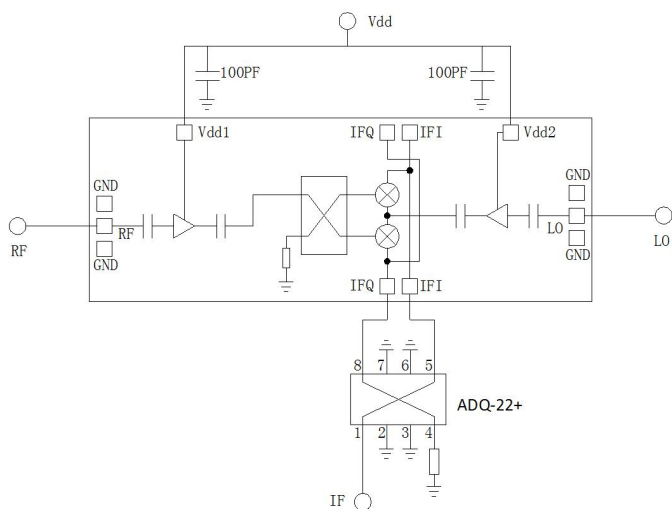




外形和端口尺寸
(以 mm 为单位)



推荐装配图



注意事项

砷化镓 MMIC 器件易受静电放电损伤。在运输、装配和试验过程中应采取防范措施。